

Содержание

- **Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)**

Дашдамирова Г.Е.

Электроннографическое исследование температурно-временных зависимостей кристаллизации нанотолщинных аморфных пленок CuIn_5Te_8 , сублимированных в обычных условиях и в условиях воздействия внешнего электрического поля 943

- **Электронные свойства полупроводников**

Расулов В.Р., Расулов Р.Я., Эшболтаев И.М., Кучкаров М.Х.

Поляризационно-спектральные зависимости трехфотонного межзонного поглощения света и линейно-циркулярного дихроизма в полупроводниках кубической симметрии . . . 948

- **Спектроскопия, взаимодействие с излучениями**

Байдакова Н.А., Яблонский А.Н., Гусев Н.С., Кудрявцев К.Е., Морозова Е.Е., Юрасов Д.В., Алешкин В.Я., Нежданов А.В., Новиков А.В.

Фотолюминесценция растянутых Ge микропостов при различных температурах: эксперимент и моделирование . . 954

- **Поверхность, границы раздела, тонкие пленки**

Тимошнев С.Н., Бенеманская Г.В., Мизеров А.М., Соболев М.С., Эннс Я.Б.

Изменение электронной структуры поверхности GaN/Si(111) при адсорбции Li 961

Кукушкин В.А.

Высокая подвижность дырок в дельта-легированных бором слоях алмаза: почему она до сих пор не достигнута и как ее можно достичь 966

- **Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления**

Хомицкий Д.В., Запруднов Н.А.

Спин-зависимое туннелирование в двойной квантовой точке в режиме „медленной“ эволюции 973

Nammas F.S., Hasan Eyad Hasan

The Analytical Effects of a Hydrostatic Pressure on the Ground State Energy of GaAs Quantum Dot at Low-Temperature: Algebraic Method 979

Петрушков М.О., Пулято М.А., Васев А.В., Абрамкин Д.С., Емельянов Е.А., Лошкарев И.Д., Комков О.С., Фирсов Д.Д., Преображенский В.В.

Молекулярно-лучевая эпитаксия GaSb на вицинальных подложках Si(001): влияние условий зарождения слоев на их структурные и оптические свойства 980

Надточий А.М., Мельниченко И.А., Иванов К.А., Минтаиров С.А., Калюжный Н.А., Максимов М.В., Крыжановская Н.В., Жуков А.Е.

Температурные зависимости излучательного и безызлучательного времени жизни носителей в квантовых яма-точках InGaAs 993

- **Физика полупроводниковых приборов**

Афанасьев А.В., Забродский В.В., Ильин В.А., Лучинин В.В., Николаев А.В., Серков А.В., Трушлякова В.В., Чигирев Д.А.

Применение технологии реактивного ионно-плазменного травления для управления чувствительностью 4H-SiC-фотодиодов 997

Бабичев А.В., Пирогов Е.В., Соболев М.С., Денисов Д.В., Фоминых Н.А., Баранов А.И., Гудовских А.С., Мельниченко И.А., Юнин П.А., Неведомский В.Н., Токарев М.В., Бер Б.Я., Гладышев А.Г., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Егоров А.Ю.

Исследование активных областей на основе многопериодных сверхрешеток GaAsN/InAs 1002

- **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

Мохов Е.Н., Давыдов В.Ю., Смирнов А.Н., Наглюк С.С.

Рост гексагонального нитрида бора (hBN) на подложках карбида кремния методом сублимации 1011

- **Персоналии**

Владимир Иванович Иванов-Омский 1016

- **Поправка** 1018

Учредители:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Российская академия наук
Ленинский пр., 14, Москва, 199000
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе
Российской академии наук
Политехническая ул., 26, Санкт-Петербург, 194021
Телефон: (812)297-2245. Факс: (812)297-1017
post@mail.ioffe.ru <http://www.ioffe.ru>

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации
Регистрационный номер ПИ № ФС77-71300 от 17 октября 2017 г.

Издатель: ФТИ им. А. Ф. Иоффе
194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Адрес редакции: 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26
semicond@mail.ioffe.ru
<http://www.ioffe.ru/journals/ftp/>

Зав. редакцией *С. Б. Короткова*

Компьютерный набор и изготовление оригинал-макета
ФТИ им. А. Ф. Иоффе
194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Подписано к печати 30.09.2022. Дата выхода в свет 31.10.2022.

Формат 60×90 1/8.

Усл. печ. л. 9.7. Уч.-изд. л. 9.3.

Тираж 45 экз.

Тип. зак. № 0000. Цена свободная.

Отпечатано с предоставленных готовых файлов
в полиграфическом центре ФГУП Издательство „Известия“
127254, Москва, ул. Добролюбова, 6
телефон: (495)650-3880, <http://izv-udprf.ru>